

SPC2017 程序册

| 日期 | 开始时间 | 结束时间 | 主题 | 报告人 | 题目 | 主持人 |
|-----------|-------|-------|-------|-----|---------------------|-----|
| 2017/7/19 | 9:00 | 22:00 | 注册 | | | |
| 2017/7/20 | 8:30 | 8:40 | 大会开幕式 | | | 郑厚植 |
| | 8:40 | 9:20 | 大会报告1 | 郑厚植 | 半导体物理进展 | 施 毅 |
| | 9:20 | 10:00 | 大会报告2 | 江风益 | 黄光LED新进展 | |
| | 10:00 | 10:30 | 照相、茶歇 | | | |
| | 10:30 | 11:10 | 大会报告3 | 张 卫 | 集成电路创新技术---从器件到工艺 | 姬 扬 |
| | 11:10 | 11:50 | 大会报告4 | 马琰铭 | 高压下的奇妙物质世界 | |
| 2017/7/21 | | | 午餐 | | | |
| | 13:30 | 14:10 | 大会报告5 | 郑有焯 | 第三代半导体 | 王开友 |
| | 14:10 | 14:50 | 大会报告6 | 彭练矛 | 碳纳米管电子学 | |
| | 14:50 | 15:10 | 茶歇 | | | |
| | 15:10 | 15:50 | 大会报告7 | 赵建华 | 高品质半导体自旋电子材料制备及性质研究 | 郑厚植 |
| | 15:50 | 16:30 | 大会报告8 | 王欣然 | 二维电子器件研究 | |
| | 16:30 | 17:00 | 大会闭幕式 | | | |

分组会议报告

半导体自旋物理与拓扑半导体会场

| 日期 | 开始时间 | 结束时间 | 主题 | 报告人 | 题目 | 所属专题 | 主持人 | |
|-----------|-----------|-------|------|---------------------------|---|---|----------|-----|
| 2017/7/20 | 13:30 | 13:55 | 邀请报告 | 许小红 | Magnetism and plasmonics of Fe, Sn- codoped In ₂ O ₃ nanodots | 1. 半导体自旋物理 | 姬 扬 | |
| | 13:55 | 14:20 | 邀请报告 | 骆军委 | Rapid saturation of the hole Rashba effect under electric field in semiconductor nanowires | 1. 半导体自旋物理 | | |
| | 14:20 | 14:45 | 邀请报告 | 安兴涛 | 谷间散射引起的谷和自旋极化 | 1. 半导体自旋物理 | | |
| | 14:45 | 15:00 | 口头报告 | 赖天树 | PbTe外延薄膜中激发电子的能量与自旋超快弛豫动力学研究 | 1. 半导体自旋物理 | | |
| | 15:00 | 15:15 | 口头报告 | 冯东海 | 半导体胶体量子点自旋探测与光致荷电动力学 | 1. 半导体自旋物理 | | |
| | 15:15 | 15:30 | 口头报告 | 马佳淋 | Magnetic properties of (Ga, Mn)As films epitaxied on GaAs (110) | 1. 半导体自旋物理 | | |
| | 15:30 | 15:45 | 口头报告 | 张发培 | Graphene-passivated cobalt as a spin-polarized electrodes for organic spintronic application | 1. 半导体自旋物理 | | |
| | 15:45 | 16:05 | 茶歇 | | | | | |
| | 16:05 | 16:30 | 邀请报告 | 姬 扬 | 自旋噪声谱测量技术及应用 | 1. 半导体自旋物理 | 许小红 | |
| | 16:30 | 16:55 | 邀请报告 | 张新惠 | 稀磁半导体(Ga, Mn)As中激光驱动的超快磁化动力学研究 | 1. 半导体自旋物理 | | |
| | 16:55 | 17:10 | 口头报告 | 滕利华 | Zn 掺杂对CdTe中载流子弛豫和自旋弛豫动力学的影响研究 | 1. 半导体自旋物理 | | |
| | 17:10 | 17:25 | 口头报告 | 陆海铭 | GaAs半导体中纯电子多体效应研究 | 1. 半导体自旋物理 | | |
| | 17:25 | 17:40 | 口头报告 | 程迎春 | 磁性近邻效应调控TMDC能谷劈裂 | 1. 半导体自旋物理 | | |
| | 17:40 | 18:30 | 张贴报告 | | | | | |
| | 2017/7/21 | 8:00 | 8:25 | 邀请报告 | 周树云 | New topological phases in transition metal dichalcogenides | 3. 拓扑半导体 | 乔振华 |
| | | 8:25 | 8:50 | 邀请报告 | 卢海舟 | Anomalous Phase Shift of Quantum Oscillations in Topological Semimetals | 3. 拓扑半导体 | |
| | | 8:50 | 9:05 | 口头报告 | 曾晓琳 | 三维拓扑绝缘体Bi ₂ Se ₃ 的自旋光电流研究 | 3. 拓扑半导体 | |
| 9:05 | | 9:20 | 口头报告 | 朱家铎 | 基于黑磷-HfS ₂ 范德华异质结的半狄拉克锥研究 | 3. 拓扑半导体 | | |
| 9:20 | | 9:35 | 口头报告 | 颜明哲 | 过渡金属硫化物PtSe ₂ 的能隙调控与新型自旋机制 | 3. 拓扑半导体 | | |
| 9:35 | | 9:50 | 口头报告 | 张会生 | Quantum anomalous and spin Hall effect in functionalized stanene on layered PbI ₂ substrate | 3. 拓扑半导体 | | |
| 9:50 | | 10:10 | 茶歇 | | | | | |
| 10:10 | | 10:35 | 邀请报告 | 乔振华 | Theory of In-Plane Magnetization Induced Quantum Anomalous Hall Effect | 3. 拓扑半导体 | 周树云 | |
| 10:35 | | 11:00 | 邀请报告 | 孙 栋 | Ultrafast Photoexcited Carrier Dynamics and Photo Response of 3D Dirac Semimetallic Cd ₃ As ₂ | 3. 拓扑半导体 | | |
| 11:00 | | 11:15 | 口头报告 | 王 琳 | 调控Cr _{1/3} NbS ₂ 中的磁性孤子的拓扑相变 | 3. 拓扑半导体 | | |
| 11:15 | | 11:30 | 口头报告 | 赵柯洋 | 二维ReS ₂ 薄膜声子模式、光学常数及光学禁带的温度效应 | 3. 拓扑半导体 | | |
| 11:30 | 11:45 | 口头报告 | 戴俊峰 | 多层二硫化钼材料中能谷自由度以及谷间散射机理的研究 | 3. 拓扑半导体 | | | |
| | | | 午餐 | | | | | |

二维材料及器件物理会场

| 日期 | 开始时间 | 结束时间 | 主题 | 报告人 | 题目 | 所属专题 | 主持人 |
|-----------|-------|-------|------|-----|---|--------------|-----|
| 2017/7/20 | 13:30 | 13:55 | 邀请报告 | 倪振华 | 基于缺陷与界面态调控的二维材料光电性能 | 2. 二维材料及器件物理 | 缪 峰 |
| | 13:55 | 14:20 | 邀请报告 | 周 鹏 | 原子晶体/金属界面接触优化与应用 | 2. 二维材料及器件物理 | |
| | 14:20 | 14:45 | 邀请报告 | 王肖沐 | 黑磷材料的能带及调控 | 2. 二维材料及器件物理 | |
| | 14:45 | 15:00 | 口头报告 | 李梦姣 | 基于二硫化钼异质结的光生载流子传输行为的实验和理论研究 | 2. 二维材料及器件物理 | |
| | 15:00 | 15:15 | 口头报告 | 吴天如 | Wafer-sized single crystalline graphene crystal from a controlled nucleus on Cu-Ni substrate | 2. 二维材料及器件物理 | |
| | 15:15 | 15:30 | 口头报告 | 张增星 | 基于双极性二维晶体的新型纳米器件研究 | 2. 二维材料及器件物理 | |
| | 15:30 | 15:45 | 口头报告 | 郭成磊 | Tunable electrical transport properties of SnSe ₂ field-effect transistors through oxygen plasma treatment | 2. 二维材料及器件物理 | |
| | 15:45 | 16:05 | 茶歇 | | | | |
| | 16:05 | 16:30 | 邀请报告 | 缪 峰 | Electronic Transport and Device Applications of 2D Materials | 2. 二维材料及器件物理 | 倪振华 |
| | 16:30 | 16:55 | 邀请报告 | 唐 宁 | 二维过渡金属硫属化合物的能谷性质研究 | 2. 二维材料及器件物理 | |
| | 16:55 | 17:10 | 口头报告 | 叶加良 | 单层WSe ₂ 中不同激子态谷寿命的超快磁光克尔谱研究 | 2. 二维材料及器件物理 | |
| | 17:10 | 17:25 | 口头报告 | 林鸿宇 | 谷间散射对石墨烯输运性质的影响 | 2. 二维材料及器件物理 | |
| | 17:25 | 18:30 | 张贴报告 | | | | |
| | | | | | | | |
| 2017/7/21 | 8:00 | 8:25 | 邀请报告 | 张 晗 | 基于二维磷全光调制及光电特性研究 | 2. 二维材料及器件物理 | 季 威 |
| | 8:25 | 8:50 | 邀请报告 | 谭青海 | 共振拉曼散射观测WS ₂ 中暗态激子与禁戒声子 | 2. 二维材料及器件物理 | |
| | 8:50 | 9:05 | 口头报告 | 吕俊鹏 | 单层WS ₂ 荧光图案化 | 2. 二维材料及器件物理 | |
| | 9:05 | 9:20 | 口头报告 | 刘巧莉 | 高响应度石墨烯/量子点复合光电晶体管 | 2. 二维材料及器件物理 | |
| | 9:20 | 9:35 | 口头报告 | 刘为振 | Study of High-Temperature Luminescence Properties of 2-dimensional Molybdenum Disulfide | 2. 二维材料及器件物理 | |
| | 9:35 | 9:50 | 口头报告 | 陈小青 | 石墨烯 / 二维有机半导体异质结光电探测器 | 2. 二维材料及器件物理 | |
| | 9:50 | 10:10 | 茶歇 | | | | |
| | 10:10 | 10:35 | 邀请报告 | 季 威 | 二维材料的层间耦合及磁性调控 | 2. 二维材料及器件物理 | 张 晗 |
| | 10:35 | 11:00 | 邀请报告 | 廖志敏 | 石墨烯及其异质结的电子输运性质 | 2. 二维材料及器件物理 | |
| | 11:00 | 11:15 | 口头报告 | 孙远慧 | InSe: a two-dimensional material with strong inter-layer coupling | 2. 二维材料及器件物理 | |
| | 11:15 | 11:30 | 口头报告 | 王 丹 | 二维半导体中带电缺陷评价方法普适化拓展的理论研究 | 2. 二维材料及器件物理 | |
| | 11:30 | 11:45 | 口头报告 | 史俊杰 | 基于硒化铟和黑磷异质结提高单层硒化铟空穴迁移率 | 2. 二维材料及器件物理 | |
| | | | | | | | |
| | | | 午餐 | | | | |

宽禁带半导体会场

| 日期 | 开始时间 | 结束时间 | 主题 | 报告人 | 题目 | 所属专题 | 主持人 |
|-----------|-------|-------|------|--|---|-----------|-----|
| 2017/7/20 | 13:30 | 13:55 | 邀请报告 | 赵德刚 | GaN基材料技术与器件物理 | 4. 宽禁带半导体 | 王新强 |
| | 13:55 | 14:20 | 邀请报告 | 龙世兵 | 基于(100) β -Ga ₂ O ₃ 单晶衬底的肖特基势垒二极管功率器件 | 4. 宽禁带半导体 | |
| | 14:20 | 14:45 | 邀请报告 | 刘 斌 | 基于微纳加工技术的III族氮化物半导体外延生长与光电子器件制备 | 4. 宽禁带半导体 | |
| | 14:45 | 15:00 | 口头报告 | 黄 凯 | 界面附近金属纳米颗粒LSP耦合波长及耦合强度特性 | 4. 宽禁带半导体 | |
| | 15:00 | 15:15 | 口头报告 | 穆文祥 | 宽禁带半导体氧化镓单晶的生长及性能表征 | 4. 宽禁带半导体 | |
| | 15:15 | 15:30 | 口头报告 | 潘书生 | 金红石相氧化钛半导体的中间带工程 | 4. 宽禁带半导体 | |
| | 15:30 | 15:45 | 口头报告 | 王婷婷 | 关于TiN及Ni肖特基二极管泄漏电流机理研究 | 4. 宽禁带半导体 | |
| | 15:45 | 16:05 | 茶歇 | | | | |
| | 16:05 | 16:30 | 邀请报告 | 王新强 | III族氮化物半导体的原子级外延调控 | 4. 宽禁带半导体 | 赵德刚 |
| | 16:30 | 16:55 | 邀请报告 | 叶建东 | 极性氧化物异质界面极化工程和输运特性 | 4. 宽禁带半导体 | |
| | 16:55 | 17:10 | 口头报告 | 徐尉宗 | 基于高k栅绝缘层Y ₂ O ₃ 制备的MIS-HEMT器件研究 | 4. 宽禁带半导体 | |
| | 17:10 | 17:25 | 口头报告 | 李 靖 | Epitaxial growth of Single-phase β -(Al _x Ga _{1-x}) ₂ O ₃ alloys by laser molecular beam epitaxy | 4. 宽禁带半导体 | |
| | 17:25 | 18:30 | 张贴报告 | | | | |
| | | | | | | | |
| 2017/7/21 | 8:00 | 8:25 | 邀请报告 | 刘 雷 | 氧化物半导体的“无序工程” | 4. 宽禁带半导体 | 张进成 |
| | 8:25 | 8:50 | 邀请报告 | 徐海阳 | Improved Ultraviolet Light-emitting Performance of ZnO-based LEDs via Interfacial Engineering | 4. 宽禁带半导体 | |
| | 8:50 | 9:05 | 口头报告 | 刘 洋 | 对AlGa _N -Ga _N 共振隧穿二极管的理论分析和仿真优化 | 4. 宽禁带半导体 | |
| | 9:05 | 9:20 | 口头报告 | 徐巧玲 | Sn(II)-Containing Phosphates as Optoelectronic Materials | 4. 宽禁带半导体 | |
| | 9:20 | 9:35 | 口头报告 | 全海燕 | 基于六方氮化硼薄膜的日盲紫外光电探测器的初步研究 | 4. 宽禁带半导体 | |
| | 9:35 | 9:50 | 口头报告 | 张武忠 | PLD法制备Be, S 共掺杂氧化锌薄膜: 结构特性与能隙调控 | 4. 宽禁带半导体 | |
| | 9:50 | 10:10 | 茶歇 | | | | |
| | 10:10 | 10:35 | 邀请报告 | 张进成 | GaN基异质结构中高密度二维电子气输运特性与调控机理 | 4. 宽禁带半导体 | 刘 雷 |
| | 10:35 | 11:00 | 邀请报告 | 陈敦军 | 极化与能带工程在AlGa _N 日盲雪崩光电探测器中的应用 | 4. 宽禁带半导体 | |
| | 11:00 | 11:15 | 口头报告 | 余 波 | 同轴结构金刚石探测器研制及应用 | 4. 宽禁带半导体 | |
| 11:15 | 11:30 | 口头报告 | 葛 梅 | 非故意掺杂Ga _N 缓冲层中缺陷能级的位置对p-GaN帽层AlGa _N /Ga _N 高迁移率晶体管性能影响 | 4. 宽禁带半导体 | | |
| 11:30 | 11:45 | 口头报告 | 徐 阳 | High-temperature β -Ga ₂ O ₃ based metal-semiconductor-metal Schottky-barrier solar blind photodetectors | 4. 宽禁带半导体 | | |
| | | | 午餐 | | | | |

有机半导体与其他半导体物理器件会场

| 日期 | 开始时间 | 结束时间 | 主题 | 报告人 | 题目 | 所属专题 | 主持人 |
|-----------|-----------|-------|------|--------------------|---|----------------------|-------------------|
| 2017/7/20 | 13:30 | 13:55 | 邀请报告 | 赵 强 | 有机半导体三重激发态的有效调控和利用 | 5. 有机半导体 | 沈国震 |
| | 13:55 | 14:20 | 邀请报告 | 蔡一茂 | 可CMOS集成的柔性多功能聚合物电子器件 | 5. 有机半导体 | |
| | 14:20 | 14:45 | 邀请报告 | Noh Yong-Young | Development of Printed Large Area Organic Transistors and Integrated Circuits | 5. 有机半导体 | |
| | 14:45 | 15:00 | 口头报告 | 保秦烨 | 面向光伏的有机半导体薄膜的界面现象 | 5. 有机半导体 | |
| | 15:00 | 15:15 | 口头报告 | 王海波 | 有机HEMT晶体管 | 5. 有机半导体 | |
| | 15:15 | 15:30 | 口头报告 | Oppong-Antwi Louis | Influence of Defect Density on Sn based perovskite solar cells with high efficiency | 5. 有机半导体 | |
| | 15:30 | 15:45 | 口头报告 | 殷 垚 | Efficient Red Perovskite Light-Emitting Diodes Based on Solution-Processed Multiple Quantum Wells | 5. 有机半导体 | |
| | 15:45 | 16:05 | 茶歇 | | | | |
| | 16:05 | 16:30 | 邀请报告 | 沈国震 | 聚合物增强的柔性电子皮肤的研究 | 5. 有机半导体 | 赵 强 |
| | 16:30 | 16:55 | 邀请报告 | 李立强 | 有机电子器件内的半导体与电极工程研究 | 5. 有机半导体 | |
| | 16:55 | 17:20 | 邀请报告 | 潘力佳 | 聚合物掺杂调控及其在器件中的应用 | 5. 有机半导体 | |
| | 17:20 | 17:35 | 口头报告 | 孙华斌 | Side Chain Engineering for High Performance Solution Processed Organic Field Effect Transistors with Novel Diketopyrrolopyrrole-Containing Small Molecule | 5. 有机半导体 | |
| | 17:35 | 18:30 | 张贴报告 | | | | |
| | 2017/7/21 | 8:00 | 8:25 | 邀请报告 | 万 青 | 氧化物神经形态晶体管及其“类脑芯片”应用 | 10. 半导体物理与器件的其他问题 |
| 8:25 | | 8:50 | 邀请报告 | 孙东明 | 低维纳米材料薄膜晶体管器件研究 | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | |
| 8:50 | | 9:05 | 口头报告 | 刘 川 | 有机薄膜晶体管的界面缺陷与体缺陷 | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | |
| 9:05 | | 9:20 | 口头报告 | 陈时友 | Na-Diffusion Enhanced p-type Conductivity in Cu(In,Ga)Se ₂ : a New Mechanism for Efficient Doping in Semiconductors | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | |
| 9:20 | | 9:35 | 口头报告 | 张 斌 | 利用光调制发射和光调制反射激发谱研究GaAsBi中的光跃迁 | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | |
| 9:35 | | 9:50 | 口头报告 | 李 芸 | 辐照诱导单晶硅复介电常数的新奇现象 | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | |
| 9:50 | | 10:10 | 茶歇 | | | | |
| 10:10 | | 10:35 | 邀请报告 | 胡志高 | 铁电氧化物材料的光电跃迁、相变规律及其物理联系 | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | 孙东明 |
| 10:35 | | 11:00 | 邀请报告 | 张 俊 | 半导体中声子的激光冷却与调控 | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | |
| 11:00 | | 11:15 | 口头报告 | 聂奎营 | Plasmonic enhancement of second harmonic generation from Ag-coated ZnTe/ZnO nanowires | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | |
| 11:15 | | 11:30 | 口头报告 | 陈念科 | 信息存储合金锗碲非晶态中的强极化结构单元 | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | |
| 11:30 | | 11:45 | 口头报告 | 朱马光 | 硅胶辅助收缩法制备大面积高密度平行碳纳米管阵列 | | |
| | | | 午餐 | | | | |

半导体低维结构及器件物理会场

| 日期 | 开始时间 | 结束时间 | 主题 | 报告人 | 题目 | 所属专题 | 主持人 |
|-----------|-------|-------|-------|------|---|---|-----------------|
| 2017/7/20 | 13:30 | 13:55 | 邀请报告 | 宋志棠 | 高密度交叉阵列结构的新型存储器件与集成 | 6. 半导体低维结构及器件物理 | 张志勇 |
| | 13:55 | 14:20 | 邀请报告 | 刘琦 | 石墨烯插层对阳离子基阻变存储器的性能调控 | 6. 半导体低维结构及器件物理 | |
| | 14:20 | 14:45 | 邀请报告 | 蔡端俊 | 二维h-BN诱导ZnO纳米柱阵列生长及其透明柔性纳米发电机 | 6. 半导体低维结构及器件物理 | |
| | 14:45 | 15:00 | 口头报告 | 李志锋 | 面向焦平面的等离激元微腔耦合量子阱红外探测器 | 6. 半导体低维结构及器件物理 | |
| | 15:00 | 15:15 | 口头报告 | 郑军 | 溅射外延GeSn/GeSiSn多量子阱材料光电性能研究 | 6. 半导体低维结构及器件物理 | |
| | 15:15 | 15:30 | 口头报告 | 张艳华 | 把二类超晶格探测器的探测波长推到1微米 | 6. 半导体低维结构及器件物理 | |
| | 15:30 | 15:45 | 口头报告 | 黄建亮 | 双色InAs/GaSb二类超晶格红外探测器 | 6. 半导体低维结构及器件物理 | |
| | 15:45 | 16:05 | 茶歇 | | | | |
| | 16:05 | 16:30 | 邀请报告 | 张志勇 | 亚10纳米碳纳米管CMOS晶体管 | 6. 半导体低维结构及器件物理 | 刘琦 |
| | 16:30 | 16:55 | 邀请报告 | 余林蔚 | 自组装平面硅纳米线形貌定制、定位集成与面向高性能显示的鳍形薄膜晶体管器件应用 | 6. 半导体低维结构及器件物理 | |
| | 16:55 | 17:10 | 口头报告 | 仲东来 | 基于碳纳米管薄膜的GHz电路 | 6. 半导体低维结构及器件物理 | |
| | 17:10 | 17:25 | 口头报告 | 张东 | 自热效应对非晶InGaZnO基薄膜晶体管可靠性的影响研究 | 6. 半导体低维结构及器件物理 | |
| | 17:25 | 18:30 | 张贴报告 | | | | |
| 2017/7/21 | 8:00 | 8:25 | 邀请报告 | 郭万林 | 低维纳米功能材料力电磁耦合性能与流致生电 | 6. 半导体低维结构及器件物理 | 廖蕾 |
| | 8:25 | 8:50 | 邀请报告 | 徐骏 | 基于纳米硅量子点的新型光电子器件研究 | 6. 半导体低维结构及器件物理 | |
| | 8:50 | 9:05 | 口头报告 | 季祥海 | 硅基InAs/GaSb异质结纳米线的MOCVD生长研究 | 6. 半导体低维结构及器件物理 | |
| | 9:05 | 9:20 | 口头报告 | 潘东 | Si衬底上分子束外延自催化生长InAs/InSb轴向异质结纳米线 | 6. 半导体低维结构及器件物理 | |
| | 9:20 | 9:35 | 口头报告 | 万能 | 快速响应的氧化石墨烯湿度传感器 | 6. 半导体低维结构及器件物理 | |
| | 9:35 | 9:50 | 口头报告 | 王曙光 | 硅微盘上锗量子点的有序生长 | 6. 半导体低维结构及器件物理 | |
| | 9:50 | 10:10 | 茶歇 | | | | |
| | 10:10 | 10:35 | 邀请报告 | 刘开辉 | Interfacial Engineering in Graphene | 6. 半导体低维结构及器件物理 | 郭万林 |
| | 10:35 | 11:00 | 邀请报告 | 廖蕾 | 理性设计基于WSe ₂ /GeSe异质结的场效应光伏型晶体管 | 6. 半导体低维结构及器件物理 | |
| | 11:00 | 11:25 | 邀请报告 | 孙立涛 | 10nm以下材料的表/界面原位研究 | 6. 半导体低维结构及器件物理 | |
| | 11:25 | 11:40 | 口头报告 | 顾溢 | InGaAs/InAlAs异变探测器应变弛豫和载流子输运调控 | 6. 半导体低维结构及器件物理 | |
| | | 11:40 | 11:55 | 口头报告 | 王积银 | Coherent transport of a linear triple quantum dot in an InAs nanowire | 6. 半导体低维结构及器件物理 |
| | | | 午餐 | | | | |

表面界面物理与半导体量子器件物理会场

| 日期 | 开始时间 | 结束时间 | 主题 | 报告人 | 题目 | 所属专题 | 主持人 |
|-----------|-------|-------|------|-----------------------------|---|--------------|-----|
| 2017/7/20 | 13:30 | 13:55 | 邀请报告 | 陈 伟 | 黑磷光电器件的界面调控 | 8. 表面与界面物理 | 吴兴龙 |
| | 13:55 | 14:20 | 邀请报告 | 王业亮 | Epitaxial Growth and Properties of Novel 2D Materials beyond Graphene | 8. 表面与界面物理 | |
| | 14:20 | 14:35 | 口头报告 | 谢伟广 | 二维氧化铝材料的制备及光电性质研究 | 8. 表面与界面物理 | |
| | 14:35 | 14:50 | 口头报告 | 于治国 | Light wavelength identification using energy distribution of hot electrons | 8. 表面与界面物理 | |
| | 14:50 | 15:05 | 口头报告 | 何少龙 | 新型二维晶体材料铅烯的电子结构研究 | 8. 表面与界面物理 | |
| | 15:05 | 15:20 | 口头报告 | 王雪鹏 | 空位有序立方相锑碲准二维非晶化及其在相变存储潜在应用 | 8. 表面与界面物理 | |
| | 15:20 | 15:35 | 口头报告 | 曹思宇 | 雪崩光电二极管中电荷层参数对实际工艺影响的理论分析 | 8. 表面与界面物理 | |
| | 15:45 | 16:05 | 茶歇 | | | | |
| | 16:05 | 16:30 | 邀请报告 | 吴兴龙 | Facet-induced optical and magnetic behavior in semiconductor micro/nanostructures | 8. 表面与界面物理 | 王业亮 |
| | 16:30 | 16:55 | 邀请报告 | 聂家财 | LaAlO ₃ /SrTiO ₃ 界面二维电子气的非传统超导配对机制研究 | 8. 表面与界面物理 | |
| | 16:55 | 17:10 | 口头报告 | 薛红霞 | LaAlO ₃ /SrTiO ₃ 异质界面上导电层厚度与温度的关系 | 8. 表面与界面物理 | |
| | 17:10 | 17:25 | 口头报告 | 张 鹏 | 混合多层VO ₂ /Al ₂ O ₃ 异质结光-电物理机制及红外开关特性 | 8. 表面与界面物理 | |
| | 17:25 | 17:40 | 口头报告 | 厉承剑 | 带隙中的电子态与钙钛矿型氧化物界面的二维电子气的起源 | 8. 表面与界面物理 | |
| | 17:40 | 18:30 | 张贴报告 | | | | |
| 2017/7/21 | 8:00 | 8:25 | 邀请报告 | 杜世萱 | Role of Cooperative Interactions in the Intercalation of Heteroatoms between Graphene and a Metal Substrate | 8. 表面与界面物理 | 郭国平 |
| | 8:25 | 8:50 | 邀请报告 | 王建禄 | 基于铁电聚合物的电子光电子器件研究 | 8. 表面与界面物理 | |
| | 8:50 | 9:05 | 口头报告 | 兰 伟 | 高性能银纳米线基三维透明电极的制备与性能研究 | 8. 表面与界面物理 | |
| | 9:05 | 9:20 | 口头报告 | 查访星 | 分子束外延生长的GaSbBi的扫描隧道显微镜表征 | 8. 表面与界面物理 | |
| | 9:20 | 9:35 | 口头报告 | 朱思新 | InAs/GaSb超晶格中折叠声学声子拉曼散射的面内各向异性研究 | 8. 表面与界面物理 | |
| | 9:35 | 9:50 | 口头报告 | 夏 彧 | 激光辅助原子探针中的场蒸发 | 8. 表面与界面物理 | |
| | 9:50 | 10:10 | 茶歇 | | | | |
| | 10:10 | 10:35 | 邀请报告 | 郭国平 | Carbon-based nano-electro-mechanics | 7. 半导体量子器件物理 | 王建禄 |
| | 10:35 | 11:00 | 邀请报告 | 王 立 | 基于分子取向调控的室温单分子器件研究 | 7. 半导体量子器件物理 | |
| | 11:00 | 11:25 | 邀请报告 | 秦 华 | 硅基射频单电子晶体管与扫描探针 | 7. 半导体量子器件物理 | |
| | 11:25 | 11:40 | 口头报告 | 翟 峰 | 多分量电子体系的隧穿时间 | 7. 半导体量子器件物理 | |
| 11:40 | 11:55 | 口头报告 | 杨英君 | 高性能碳纳米管薄膜互补性场效应晶体管和中等规模集成电路 | 7. 半导体量子器件物理 | | |
| | | | 午餐 | | | | |

半导体发光物理会场

| 日期 | 开始时间 | 结束时间 | 主题 | 报告人 | 题目 | 所属专题 | 主持人 |
|-----------|-------|-------|------|----------------------|---|------------|-----|
| 2017/7/20 | 13:30 | 13:55 | 邀请报告 | 黄永箴 | 基于双稳态正方形-长方形耦合腔激光器的全光触发器 | 9. 半导体发光物理 | 陈张海 |
| | 13:55 | 14:20 | 邀请报告 | 皮孝东 | 基于可印刷硅量子点的近红外发光二极管 | 9. 半导体发光物理 | |
| | 14:20 | 14:45 | 邀请报告 | 施 卫 | 高阻GaAs光激发电荷畴猝灭模式及其应用 | 9. 半导体发光物理 | |
| | 14:45 | 15:00 | 口头报告 | 凯 余 | 锡自催化横向生长的硅基无位错GeSn材料 | 9. 半导体发光物理 | |
| | 15:00 | 15:15 | 口头报告 | 吴仰晴 | 稀土离子掺杂二氧化钛纳米晶的上转换红光发射研究 | 9. 半导体发光物理 | |
| | 15:15 | 15:30 | 口头报告 | 仇庆前 | Ga30Sb70/Ge8Sb92类超晶格薄膜的超快激光晶化行为的结构调控与机理研究 | 9. 半导体发光物理 | |
| | 15:30 | 15:45 | 口头报告 | 陈熙仁 | InAs/GaSb超晶格面内扫描中红外光致发光光谱研究 | 9. 半导体发光物理 | |
| | 15:45 | 16:05 | 茶歇 | | | | |
| | 16:05 | 16:30 | 邀请报告 | 陈张海 | Fano Resonance of Polariton and Second Harmonic Generation | 9. 半导体发光物理 | 皮孝东 |
| | 16:30 | 16:55 | 邀请报告 | 牛智川 | 半导体量子点量子光源器件 | 9. 半导体发光物理 | |
| | 16:55 | 17:20 | 邀请报告 | 邵 军 | 中、长波红外砷掺杂碲镉汞退火激活的光致发光谱分析 | 9. 半导体发光物理 | |
| | 17:20 | 17:35 | 口头报告 | 霍永恒 | 基于GaAs (001) 衬底的高品质GaAs量子点纠缠光子源 | 9. 半导体发光物理 | |
| | 17:35 | 18:30 | 张贴报告 | | | | |
| | | | | | | | |
| 2017/7/21 | 8:00 | 8:25 | 邀请报告 | 熊启华 | Probing Exciton and Exciton Polaritons in Semiconductor Nanomaterials | 9. 半导体发光物理 | 曹俊诚 |
| | 8:25 | 8:50 | 邀请报告 | 李传波 | 硅基锗锡发光材料与器件 | 9. 半导体发光物理 | |
| | 8:50 | 9:05 | 口头报告 | 耶红刚 | ZnO单晶长寿命磷光现象与机制研究 | 9. 半导体发光物理 | |
| | 9:05 | 9:20 | 口头报告 | 刘 桃 | GeSn薄膜材料的分子束外延生长和发光性质研究 | 9. 半导体发光物理 | |
| | 9:20 | 9:35 | 口头报告 | 黄 锐 | 高密度硅量子点的近红外光发射调控与光增益特性 | 9. 半导体发光物理 | |
| | 9:35 | 9:50 | 口头报告 | 杨 濛 | 深沟槽完美吸收结构硅基热电子红外探测器 | 9. 半导体发光物理 | |
| | 9:50 | 10:10 | 茶歇 | | | | |
| | 10:10 | 10:35 | 邀请报告 | 曹俊诚 | 太赫兹半导体量子器件及其应用 | 9. 半导体发光物理 | 熊启华 |
| | 10:35 | 11:00 | 邀请报告 | 徐春祥 | 表面等离子激元耦合的ZnO回音壁模激光特性调控 | 9. 半导体发光物理 | |
| | 11:00 | 11:15 | 口头报告 | 王兴军 | Bi元素对GaAs纳米线晶体结构和发光极化特性的影响 | 9. 半导体发光物理 | |
| | 11:15 | 11:30 | 口头报告 | 曹玉莲 | 中红外铋化物带间级联激光器 | 9. 半导体发光物理 | |
| 11:30 | 11:45 | 口头报告 | 陈少强 | 增益开关半导体激光器超短脉冲输出特性研究 | 9. 半导体发光物理 | | |
| | | | 午餐 | | | | |

半导体物理与器件其他问题会场

| 日期 | 开始时间 | 结束时间 | 主题 | 报告人 | 题目 | 所属专题 | 主持人 |
|-----------|-------|-------|------|---|--|-------------------|-----|
| 2017/7/20 | 13:30 | 13:55 | 邀请报告 | 唐 江 | 硒化铋薄膜太阳能电池研究进展 | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | 沈文忠 |
| | 13:55 | 14:20 | 邀请报告 | 王建浦 | Perovskite Light-Emitting Diodes based on Solution-Processed Multiple Quantum Wells | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | |
| | 14:20 | 14:45 | 邀请报告 | 曾海波 | 面向新型显示的全无机钙钛矿发光量子点 | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | |
| | 14:45 | 15:10 | 邀请报告 | 何海平 | 铅卤钙钛矿材料中的激子复合特性 | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | |
| | 15:10 | 15:25 | 口头报告 | 史志锋 | 基于全无机异质结构的钙钛矿发光器件研究 | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | |
| | 15:25 | 15:40 | 口头报告 | 杨东问 | Functionality-directed Screening of Pb-free Hybrid Organic-inorganic Perovskites with Desired Intrinsic Photovoltaic Functionalities | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | |
| | 15:40 | 16:05 | 茶歇 | | | | |
| | 16:05 | 16:30 | 邀请报告 | 沈文忠 | Bridging Scientific Research and Industry in Crystalline Silicon Solar Cells | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | 唐 江 |
| | 16:30 | 16:45 | 口头报告 | 张 毅 | 溅射硒化法制备Cu ₂ ZnSn (S, Se) 4薄膜太阳能电池 | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | |
| | 16:45 | 17:00 | 口头报告 | 孙肖林 | 硅纳米线径向结柔性薄膜太阳能电池的研究 | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | |
| | 17:00 | 17:15 | 口头报告 | Zidong Guo | Solution-processed high-k amorphous ytterbium oxide dielectrics for low-voltage In ₂ O ₃ thin-film transistors | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | |
| | 17:15 | 17:30 | 口头报告 | 欧阳威 | 非晶氧化铟基薄膜晶体管的电学稳定性机制研究 | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | |
| | 17:30 | 18:30 | 张贴报告 | | | | |
| 2017/7/21 | 8:00 | 8:25 | 邀请报告 | 赵 毅 | 锗基CMOS器件的界面与沟道特性研究 | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | 张立军 |
| | 8:25 | 8:50 | 邀请报告 | 韩根全 | 锗与锗锡量子阱高迁移率沟道MOSFET和Beyond CMOS器件 | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | |
| | 8:50 | 9:05 | 口头报告 | 敬 莹 | 锗沟道鳍型晶体管 (FinFET) 声子散射限制的电子迁移率研究 | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | |
| | 9:05 | 9:20 | 口头报告 | 王 刚 | FinFET沟道表面氢热处理的优化研究 | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | |
| | 9:20 | 9:35 | 口头报告 | Caixuan Fan | Solution-processed sub-3 V SrO _x -gated oxide thin-film transistors and inverters | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | |
| | 9:35 | 9:50 | 口头报告 | 马英杰 | 气态源分子束外延生长的InGaAsP中Be补偿掺杂机制 | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | |
| | 9:50 | 10:10 | 茶歇 | | | | |
| | 10:10 | 10:35 | 邀请报告 | 张立军 | Computational Design of Functional Semiconductor Materials | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | 赵 毅 |
| | 10:35 | 10:50 | 口头报告 | 贺 欣 | Swarm-Intelligence Guided Computational Design of New Zintl Phases of Ba-Si Compounds | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | |
| | 10:50 | 11:05 | 口头报告 | 刘 梦 | 基于第一性原理对锗铅 (GePb) 合金能带结构的分析 | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | |
| | 11:05 | 11:20 | 口头报告 | 李天姝 | Intrinsic and extrinsic defect properties of solar material BaSi ₂ | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | |
| | 11:20 | 11:35 | 口头报告 | 龙德兵 | 基于密度泛函理论的CdS _{1-x} Se _x 合金电子和热力学性质的第一性原理研究 | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | |
| 11:35 | 11:50 | 口头报告 | 王雪婷 | Swarm-Intelligence Guided Computational Design of Tin Sulfide Semiconductors as Earth-abundant Photovoltaic Materials | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | | |
| 11:20 | 11:35 | 口头报告 | 陈 俊 | 光电探测器性能模拟 | 10. 半导体物理与器件的其他问题 | | |
| | | | 午餐 | | | | |

半导体低维器件物理会场

| 日期 | 开始时间 | 结束时间 | 主题 | 报告人 | 题目 | 所属专题 | 主持人 |
|-----------|-----------|-------|------|-------------------------|--|---|-----------------|
| 2017/7/20 | 13:30 | 13:55 | 邀请报告 | 狄增峰 | 锗基石墨烯材料生长研究 | 2. 二维材料及器件物理 | 张广宇 |
| | 13:55 | 14:20 | 邀请报告 | 魏钟鸣 | 新型二维半导体的制备与器件性能研究 | 2. 二维材料及器件物理 | |
| | 14:20 | 14:45 | 邀请报告 | 王浩敏 | 面向微纳电子学应用的石墨烯纳米带制备与物性研究 | 2. 二维材料及器件物理 | |
| | 14:45 | 15:00 | 口头报告 | 蒋天然 | PLD制备WSe ₂ 薄膜的超快载流子动力学研究 | 2. 二维材料及器件物理 | |
| | 15:00 | 15:15 | 口头报告 | 田慧军 | 石墨烯/p-GaN紫外光探测器 | 2. 二维材料及器件物理 | |
| | 15:15 | 15:30 | 口头报告 | 田 振 | Electronic transport and STM study on IV-VI semiconductors | 2. 二维材料及器件物理 | |
| | 15:30 | 15:45 | 口头报告 | 朱伟玲 | 单层二硒化钼的能带和吸收光谱的应变调控 | 2. 二维材料及器件物理 | |
| | 15:45 | 16:05 | 茶歇 | | | | |
| | 16:05 | 16:30 | 邀请报告 | 张广宇 | 单层MoS ₂ 的外延及场效应器件 | 2. 二维材料及其器件物理 | 狄增峰 |
| | 16:30 | 16:55 | 邀请报告 | 何 军 | 低维硫族半导体材料：设计、合成及器件应用 | 2. 二维材料及其器件物理 | |
| | 16:55 | 17:20 | 邀请报告 | 徐 杨 | 高性能硅基石墨烯光电探测器 | 2. 二维材料及其器件物理 | |
| | 17:20 | 17:35 | 口头报告 | 郭 敏 | 氧化石墨烯的超快动力学研究 | 2. 二维材料及其器件物理 | |
| | 17:35 | 18:30 | 张贴报告 | | | | |
| | 2017/7/21 | 8:00 | 8:25 | 邀请报告 | 潘安练 | Band Gap Engineering and Heterostructures of Low Dimensional Semiconductors | 6. 半导体低维结构及器件物理 |
| 8:25 | | 8:50 | 邀请报告 | 康 宁 | 基于InSb纳米线超导复合器件的运输研究 | 6. 半导体低维结构及器件物理 | |
| 8:50 | | 9:05 | 口头报告 | 王吉米 | 基于高质量纳米液滴扫描晶化过程的高性能全透明平面纳米线Fin结构薄膜晶体管 | 6. 半导体低维结构及器件物理 | |
| 9:05 | | 9:20 | 口头报告 | 王晓芳 | Phase transition characteristics of GeSb thin films | 6. 半导体低维结构及器件物理 | |
| 9:20 | | 9:35 | 口头报告 | 周以峰 | InAs/GaSb核壳纳米线的低温电学输运研究 | 6. 半导体低维结构及器件物理 | |
| 9:35 | | 9:50 | 口头报告 | 肖梦梦 | 基于碳管薄膜晶体管的超高灵敏度氢气传感器 | 6. 半导体低维结构及器件物理 | |
| 9:50 | | 10:10 | 茶歇 | | | | |
| 10:10 | | 10:35 | 邀请报告 | 胡伟达 | 新型高增益低维红外光电探测器 | 6. 半导体低维结构及器件物理 | 潘安练 |
| 10:35 | | 11:00 | 邀请报告 | 王枫秋 | 三维狄拉克半金属Cd ₃ As ₂ 的超快非线性光学性能及其应用 | 6. 半导体低维结构及器件物理 | |
| 11:00 | | 11:25 | 口头报告 | 黄少云 | InAs半导体纳米线多量子点耦合自旋量子器件 | 6. 半导体低维结构及器件物理 | |
| 11:25 | | 11:40 | 口头报告 | 吕尊仁 | Si掺杂1.3微米InAs/GaAs量子点激光器 | 6. 半导体低维结构及器件物理 | |
| 11:40 | 11:55 | 口头报告 | 朱亮清 | 量子级联红外探测器的子带能级跃迁及磁光性质研究 | 6. 半导体低维结构及器件物理 | | |
| | | | 午餐 | | | | |